

シリコンNPN三重拡散メサ形トランジスタ  
SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR (TENTATIVE)

2SD371

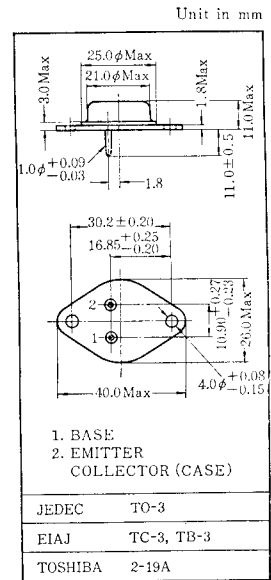
○電力増幅用

○ Power Amplifier Applications

- コレクタ損失が大きい。 :  $P_C = 50W$
- 高耐圧です。 :  $V_{CE0} = 80V$
- 2SB531 とコンプリメンタリになります。
- 30W Hi-Fi オーディオアンプ出力段に最適です。
- Complementary to 2SB531
- Recommended for 30W High-Fidelity Audio Frequency Amplifier Output Stage.

最大定格 MAXIMUM RATINGS ( $T_a = 25^\circ C$ )

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	90	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0}$	80	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EB0}$	5	V
コレクタ電流	$I_C$	6	A
エミッタ電流	$I_E$	-6	A
コレクタ損失	$P_C$	50	W
接合温度	$T_J$	150	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-65~150	$^\circ C$



アクセサリはAC73を適用  
MOUNTING KIT NO. AC73

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a = 25^\circ C$ )

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CE} = 50V, I_E = 0$	—	—	100	$\mu A$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = 5V, I_C = 0$	—	—	100	$\mu A$
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CE0}$	$I_C = 0.1A, I_B = 0$	80	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = 10mA, I_C = 0$	5	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (Note)	$V_{CE} = 5V, I_C = 1A$	40	—	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = 5V, I_C = 4A$	20	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 4A, I_B = 0.4A$	—	—	2.5	V
ベース・エミッタ間電圧	$V_{BE}$	$V_{CE} = 5V, I_C = 4A$	—	—	1.5	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE} = 5V, I_E = -1A$	—	8	—	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = 10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	100	—	pF

Note ;  $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of  $h_{FE(1)}$ , the 2SD371 is classified as follows.

Classification	Min.	Max.
2SD371—R	40	80
2SD371—O	70	140
2SD371—Y	120	240